










	<h2 style="color: red;">IPD082N10N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD082N10N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3
	Datenblätter:	 IPD082N10N3GATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD082N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPD082N10N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD082N10N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD082N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD082N10N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD082N10N3G infineon IPD082N10N3G infineon	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD088N04L G INFINEON IPD088N04L G INFINEON	 IPD082N10N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD088N04LG Infineon IPD088N04LG Infineon
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD07N50C3 Original TO-251	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD082N10N3 G INFINEON IPD082N10N3 G INFINEON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD07N03L INFINEON IPD07N03L INFINEON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD07N03LA I IPD07N03LA I

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD082N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD082N10N3GATMA1 Datenblatt	IPD082N10N3GATMA1-Datenblätter	IPD082N10N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD082N10N3GATMA1
IPD082N10N3GATMA1 Electronic	IPD082N10N3GATMA1-Komponenten	IPD082N10N3GATMA1-Verteiler	IPD082N10N3GATMA1-Bild	IPD082N10N3GATMA1-Teil
IPD082N10N3GATMA1 Preis	IPD082N10N3GATMA1 Hersteller	IPD082N10N3GATMA1 Bild	IPD082N10N3GATMA1 Aktie	IPD082N10N3GATMA1 Inventar
IPD082N10N3GATMA1 Neu	IPD082N10N3GATMA1 Original	IPD082N10N3GATMA1 garantiert	IPD082N10N3GATMA1 RFQ	IPD082N10N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited